

О СВЯЗИ ТЕРМОЭДС УВЛЕЧЕНИЯ С АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

И. М. Суслов

Показано, что термоэдс увлечения определяется некоторым взвешенным средним от акустоэлектрического коэффициента по направлениям и поляризациям звука.

Термоэдс Q есть кинетический коэффициент, определяющий возникающее в образце электрическое поле \mathbf{E} при наличии в нем градиента температуры ∇T и отсутствии электрического тока \mathbf{j} :

$$\mathbf{E} = Q \nabla T, \quad \mathbf{j} = 0$$

(для кристалла с кубической симметрией). В металле при низких температурах термоэдс Q представляется в виде суммы [1]

$$Q = Q_e + Q_{ph} = aT + bT^3, \quad (1)$$

где первый член связан с непосредственным воздействием градиента температуры на электронную систему, а второй — с увлечением электронов потоком фононов, созданным градиентом температуры.

Термоэдс увлечения Q_{ph} по физической природе родственна с акустоэлектрическим эффектом, который состоит в возбуждении электрического тока (или ЭДС) при распространении по металлу звуковой волны. Зава-рицким [2] установлено порядковое соотношение между термоэдс Q_{ph} и акустоэлектрическим коэффициентом ξ :

$$Q_{ph} \sim C_{ph} s \xi, \quad (2)$$

где C_{ph} — теплоемкость решетки, s — скорость звука. Входящий в (2) акустоэлектрический коэффициент ξ соответствует наиболее естественной постановке опыта [2] и определяется как коэффициент пропорциональности между разностью потенциалов ΔV на концах длинного образца, наведенной распространяющейся по образцу (и полностью затухающей в нем) звуковой волной, и ее начальной плотностью потока энергии W :

$$\Delta V = \xi W. \quad (3)$$

Для металла с изотропными характеристиками соотношение (2) является точным с коэффициентом $1/3$ в правой части.

Оказывается, что аналог соотношения (2) можно получить и для реального анизотропного металла. При этом Q_{ph} определяется некоторым взвешенным средним от $\xi(\mathbf{n})$ (\mathbf{n} — направление относительно кристаллографических осей) по направлениям \mathbf{n} . Это легко понять, если представить, что сначала градиент температуры выводит из равновесия фононы, а затем они за счет акустоэлектрического эффекта создают термоэдс. Вес, с которым происходит усреднение $\xi(\mathbf{n})$, вообще говоря, нетривиален, так как зависит от характера неравновесности фононов. Однако в низкотемпературном пределе его удается найти точно.

Запишем систему кинетических уравнений для электронной и фононной функций распределения при наличии градиента температуры. Пренебрегая рассеянием фононов за счет всех прочих механизмов, кроме элек-

тронного (что оправдано в металлах при низких температурах)¹⁾, исключим из первого уравнения неравновесную фононную функцию распределения ([3, § 82]) и приведем его к виду

$$X_k^T = -\frac{\varepsilon_k - \mu}{T} \frac{\partial f_k^0}{\partial \varepsilon_k} v_k \nabla T + \sum_{k'q\lambda} \left[(P_{kq\lambda}^{k'} - P_k^{k'q\lambda}) \cdot \right. \\ \left. \cdot \left(2T \sum_{k_1 k_2} P_{k_1 q \lambda}^{k_2} \right)^{-1} \hbar \omega_{q\lambda} \frac{\partial n_{q\lambda}^0}{\partial (\hbar \omega_{q\lambda})} v_{q\lambda} \nabla T \right] = \hat{L} \Phi_k, \quad (4)$$

где ε_k и v_k — энергия и групповая скорость электронов с квазиимпульсом \mathbf{k} ; $\omega_{q\lambda}$ и $v_{q\lambda}$ — частота и групповая скорость фононов с квазиимпульсом \mathbf{q} и поляризацией λ ; f_k^0 и $n_{q\lambda}^0$ — функции распределения Ферми и Бозе, Φ_k — введена соотношением

$$f_k = f_k^0 - \frac{\partial f_k^0}{\partial \varepsilon_k} \Phi_k$$

(f_k — неравновесная функция распределения электронов); \hat{L} — интегральный оператор столкновений (учитывающий всевозможные электронные столкновения, а также увлечение электронов фононами); $P_{kq\lambda}^{k'}$ и $P_k^{k'q\lambda}$ — вероятности электрон-фононных переходов:

$$P_{kq\lambda}^{k'} = \sum_{\mathbf{g}} \frac{2\pi}{\hbar} |g_{k'k}^{\lambda}|^2 f_k^0 (1 - f_{k'}^0) n_{q\lambda}^0 \delta(\varepsilon_{k'} - \varepsilon_k - \hbar \omega_{q\lambda}) \delta_{k' - k - \mathbf{q}, \mathbf{g}}, \\ P_k^{k'q\lambda} = \sum_{\mathbf{g}} \frac{2\pi}{\hbar} |g_{k'k}^{\lambda}|^2 f_k^0 (1 + n_{q\lambda}^0) \delta(\varepsilon_{k'} - \varepsilon_k + \hbar \omega_{q\lambda}) \delta_{k' - k + \mathbf{q}, \mathbf{g}},$$

где $g_{k'k}^{\lambda}$ — матричный элемент электрон-фононного взаимодействия, связанный с соответствующей компонентой деформационного потенциала Λ_k соотношением

$$|g_{k'k}^{\lambda}|^2 = \hbar q^2 |\Lambda_k|^2 / 2\rho \omega_{q\lambda}.$$

Мы должны найти Φ_k из уравнения (4) и вычислить термоэлектрический ток. Удобнее, однако, воспользовавшись методом работы [4], выразить термоэлектрический ток \mathbf{j}^T через другую функцию Ψ_k , являющуюся решением кинетического уравнения

$$\frac{\partial f_k^0}{\partial \varepsilon_k} v_k = \hat{L} \Psi_k, \quad (5)$$

используемого в теории электропроводности. Возможность этого следует из формальной цепочки равенств:

$$\mathbf{j}^T = -2e \sum_{\mathbf{k}} v_{\mathbf{k}} \frac{\partial f_{\mathbf{k}}^0}{\partial \varepsilon_{\mathbf{k}}} \Phi_{\mathbf{k}} = -2e \left(v_{\mathbf{k}} \frac{\partial f_{\mathbf{k}}^0}{\partial \varepsilon_{\mathbf{k}}}, \Phi_{\mathbf{k}} \right) = \\ = -2e \left(v_{\mathbf{k}} \frac{\partial f_{\mathbf{k}}^0}{\partial \varepsilon_{\mathbf{k}}}, \hat{L}^{-1} X_{\mathbf{k}}^T \right) = -2e \left(\hat{L}^{-1} v_{\mathbf{k}} \frac{\partial f_{\mathbf{k}}^0}{\partial \varepsilon_{\mathbf{k}}}, X_{\mathbf{k}}^T \right) = -2e (\Psi_{\mathbf{k}}, X_{\mathbf{k}}^T)$$

¹⁾ Окончательные формулы (8), (9) сохраняются и при наличии других механизмов рассеяния фононов, если их можно описывать в τ -приближении; при этом Γ и ζ в (8) и (9) должны быть определены с учетом этих дополнительных механизмов рассеяния.

(использована эрмитовость оператора \hat{L}). Соответственно для термоэдс получим

$$Q = Q_e + Q_{ph},$$

$$Q_e = + \frac{2e}{3\sigma} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\varepsilon_{\mathbf{k}-\mu}}{T} \frac{\partial f_{\mathbf{k}}^0}{\partial \varepsilon_{\mathbf{k}}} \psi_{\mathbf{k}V_{\mathbf{k}}}, \quad (6)$$

$$Q_{ph} = \frac{e}{3\sigma T} \sum_{q\lambda} \hbar \omega_{q\lambda} \frac{\partial n_{q\lambda}^0}{\partial (\hbar \omega_{q\lambda})} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} (P_{\mathbf{k}q\lambda}^{\mathbf{k}'} - P_{\mathbf{k}'q\lambda}^{\mathbf{k}}) \psi_{\mathbf{k}V_{q\lambda}} / \sum_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} P_{\mathbf{k}q\lambda}^{\mathbf{k}'},$$

где σ — проводимость (для упрощения записи мы предположили кубическую симметрию кристалла). Выражение для Q_e в случае медленной энергетической зависимости $\psi_{\mathbf{k}}$ сводится к известной формуле Мотта [1]. Выражение для Q_{ph} упрощается в пределе низких температур, когда импульс теплового фонона меньше всех характерных размеров ферми-поверхности:

$$Q_{ph} = \frac{\pi}{90} \frac{e}{\sigma} T^3 \sum_{\lambda} \int \frac{d\Omega_{\hat{q}}}{(\hbar s_{q\lambda})^4} v_{q\lambda} \int \frac{|\Lambda_{\mathbf{k}}|^2}{v_{\mathbf{k}}^2} \cdot \frac{\partial \psi_{\mathbf{k}}}{\partial k_q} \delta(\cos \theta) dS_{\mathbf{k}} / \int \frac{|\Lambda_{\mathbf{k}}|^2}{v_{\mathbf{k}}^2} \delta(\cos \theta) dS_{\mathbf{k}}, \quad (7)$$

где θ — угол между \mathbf{q} и $\mathbf{v}_{\mathbf{k}}$; $s_{q\lambda}$ — фазовая скорость фонона; интегрирование производится по направлениям $\hat{q} = \mathbf{q}/q$. Входящие в (7) интегралы по $S_{\mathbf{k}}$ оказываются такими же, как в выражениях для акустоэлектрического тока j^A [4] и коэффициента поглощения звука Γ [5]:

$$j_{q\lambda}^A = \frac{eqW}{(2\pi\hbar)^2 \rho v_{q\lambda} s_{q\lambda}} \int \frac{|\Lambda_{\mathbf{k}}|^2}{v_{\mathbf{k}}^2} \frac{\partial \psi_{\mathbf{k}}}{\partial k_q} \delta(\cos \theta) dS_{\mathbf{k}},$$

$$\Gamma_{q\lambda} = \frac{q}{(2\pi)^2 \hbar \rho v_{q\lambda}} \int \frac{|\Lambda_{\mathbf{k}}|^2}{v_{\mathbf{k}}^2} \delta(\cos \theta) dS_{\mathbf{k}}.$$

Используя эти выражения, запишем (7) в виде

$$Q_{ph} = \frac{\pi}{90} \frac{T^3}{\sigma} \sum_{\lambda} \int \frac{d\Omega_{\hat{q}}}{(\hbar s_{q\lambda})^3} \frac{j_{q\lambda}^A \mathbf{v}_{q\lambda}}{\Gamma_{q\lambda}}, \quad (8)$$

где $j_{q\lambda}^{A(0)}$ — значение $j_{q\lambda}^A$ при $W=1$. Заметив, что акустоэлектрический коэффициент ζ , измеренный в направлении $\mathbf{v}_{q\lambda}$, связан с $j_{q\lambda}^A$ следующим образом:

$$\zeta^{\lambda}(\hat{\mathbf{v}}_{q\lambda}) = j_{q\lambda}^{A(0)} \hat{\mathbf{v}}_{q\lambda} / \Gamma_{q\lambda} \sigma,$$

получим искомое соотношение между Q_{ph} и $\zeta(\mathbf{n})$:

$$Q_{ph} = \frac{\pi}{90} T^3 \sum_{\lambda} \int d\Omega_{\hat{q}} \frac{v_{q\lambda}}{(\hbar s_{q\lambda})^3} \zeta^{\lambda}(\hat{\mathbf{v}}_{q\lambda}). \quad (9)$$

Таким образом, хотя явное вычисление каждой из величин Q_{ph} и $\zeta(\mathbf{n})$ по отдельности в общем случае невозможно, между ними удается установить точное количественное соотношение.

Автор признателен А. Ф. Андрееву, Н. В. Заварицкому и М. И. Каганову за обсуждение результатов работы.

Литература

1. *Займан Дж.* Электроны и фононы. М.: ИИЛ, 1962.
2. *Заварицкий Н. В.* ЖЭТФ, 1978, 75, 1873.
3. *Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П.* Физическая кинетика. М.: Наука, 1979.
4. *Каганов М. И., Мевлют Ш. Т., Суслов И. М.* ЖЭТФ, 1980, 78, 376.
5. *Ахиезер А. И., Каганов М. И., Любарский Г. Я.* ЖЭТФ, 1957, 32, 837.

Институт физических проблем
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
2.VI.1983

ON THE RELATION BETWEEN THE PHONON DRAG THERMOPOWER AND THE ELECTROACOUSTIC COEFFICIENT

I. M. Suslov

It is shown that the Phonon drag thermopower is determined by a certain average of the electroacoustic coefficient with respect to directions and polarizations of the sound.